CZT5551

SURFACE MOUNT SILICON NPN TRANSISTOR

SOT-223 CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CZT5551 is a silicon NPN transistor manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for high voltage amplifier applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	180	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	160	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0	V
Continuous Collector Current	I_C	600	mA
Power Dissipation	P_D	2.0	W
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	62.5	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_A=25°C unless otherwise noted)

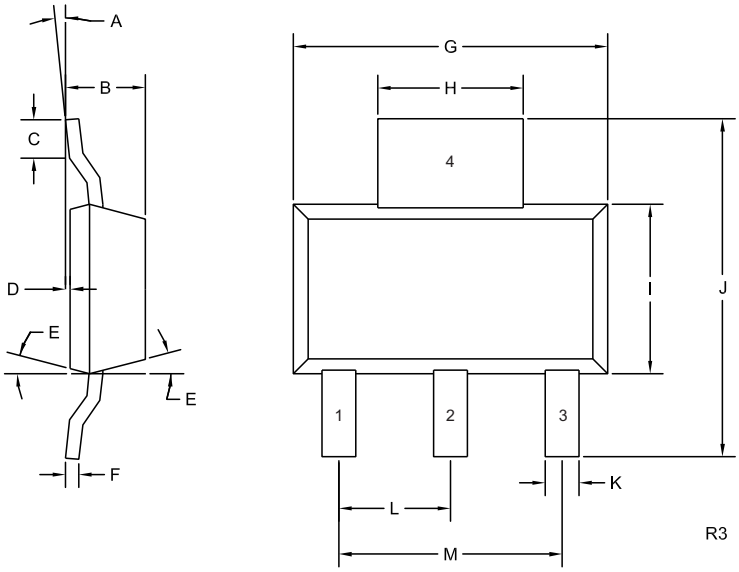
SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**MAX**	**UNITS**
I_{CBO}	V_{CB}=120V		50	nA
I_{CBO}	V_{CB}=120V, T_A=100°C		50	µA
I_{EBO}	V_{EB}=4.0V		50	nA
BV_{CBO}	I_C=100µA	180		V
BV_{CEO}	I_C=1.0mA	160		V
BV_{EBO}	I_E=10µA	6.0		V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=10mA, I_B=1.0mA		0.15	V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=50mA, I_B=5.0mA		0.20	V
$V_{BE(SAT)}$	I_C=10mA, I_B=1.0mA		1.00	V
$V_{BE(SAT)}$	I_C=50mA, I_B=5.0mA		1.00	V
h_{FE}	V_{CE}=5.0V, I_C=1.0mA	80		
h_{FE}	V_{CE}=5.0V, I_C=10mA	80	250	
h_{FE}	V_{CE}=5.0V, I_C=50mA	30		
f_T	V_{CE}=10V, I_C=10mA, f=100MHz	100	300	MHz
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz		6.0	pF
C_{ib}	V_{EB}=0.5V, I_C=0, f=1.0MHz		20	pF
h_{fe}	V_{CE}=10V, I_C=1.0mA, f=1.0kHz	50	200	
NF	V_{CE}=5.0V, I_C=200µA, R_S=10Ω, f=10Hz to 15.7kHz		8.0	dB

R5 (11-June 2013)

CZT5551

SURFACE MOUNT SILICON
NPN TRANSISTOR

SOT-223 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:
1) Base
2) Collector
3) Emitter
4) Collector

MARKING:
FULL PART NUMBER

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0°	10°	0°	10°
B	0.059	0.071	1.50	1.80
C	0.018	---	0.45	---
D	0.000	0.004	0.00	0.10
E	15°		15°	
F	0.009	0.014	0.23	0.35
G	0.248	0.264	6.30	6.70
H	0.114	0.122	2.90	3.10
I	0.130	0.146	3.30	3.70
J	0.264	0.287	6.70	7.30
K	0.024	0.033	0.60	0.85
L	0.091		2.30	
M	0.181		4.60	

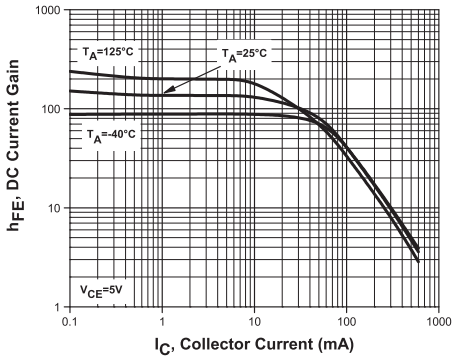
SOT-223 (REV: R3)

CZT5551

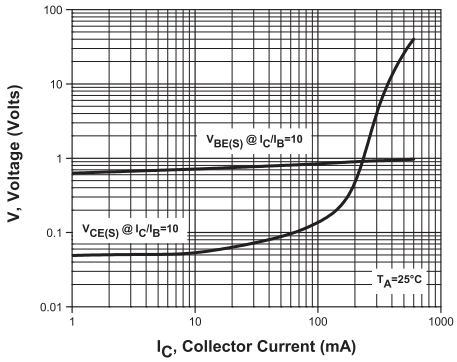
SURFACE MOUNT SILICON NPN TRANSISTOR

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

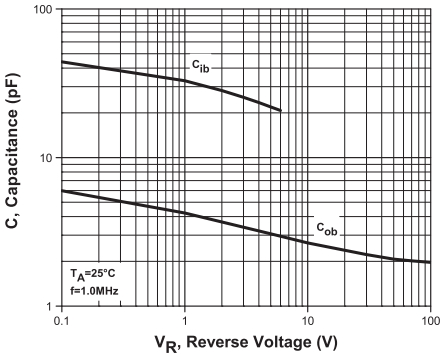
DC Current Gain



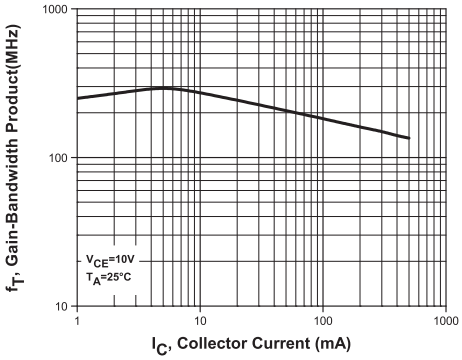
"ON" Voltage



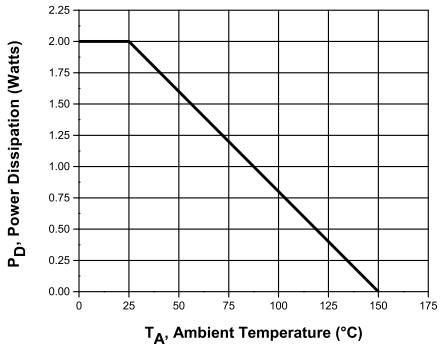
Capacitance



Current Gain-Bandwidth Product



Power Derating



R5 (11-June 2013)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9